

# طراحی و ساخت بالاست الکترونیکی برای لامپ های گازی (بخار جیوه و بخار سدیم)

شرکت مسن انرژی قشم

مجری: شرکت مسن انرژی قشم

محل انجام کار: شرکت ساخت صنعت گلستان

سال پایان: ۹۸

سال شروع: ۹۷

## معرفی پروژه:

لامپهای تخلیه در گاز، بار قابل توجهی از شبکه توزیع برق را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر برای روشن نمودن آنها از بالاستهای مغناطیسی استفاده می‌شود. با پیشرفت المانهای الکترونیک قدرت، امکان ساخت بالاستهای الکترونیکی فراهم شده و تحقیقات نشان می‌دهد استفاده از بالاستهای الکترونیکی در مقایسه با بالاستهای مغناطیسی، باعث افزایش طول عمر لامپ تا دو برابر، افزایش ضریب قدرت، حذف اثر سوسوزدن، ایجاد شار نوری ثابت در تغییرات وسیع ولتاژ ورودی، کنترل نور، امکان مدیریت مصرف انرژی روشنائی، کاهش ۵ تا ۱۰ درصد مصرف انرژی در شار نوری ثابت و ... خواهد شد. مزایای فوق و به خصوص کاهش مصرف انرژی، اهمیت تحقیق به منظور طراحی و ساخت این گروه از بالاستهای الکترونیکی را نشان می‌دهد هدف از انجام این پروژه طراحی و ساخت بالاست الکترونیکی برای لامپ ۲۵۰ وات سدیم و ۲۵۰ وات جیوه می‌باشد.

مراحل انجام پروژه شامل موارد زیر بوده:

خلاصه اقدامات انجام شده در این پروژه شامل موارد زیر بوده است:

۴- ساخت نمونه نهایی و انجام تستهای عملکرد در آزمایشگاه روشنائی دانشکده فنی دانشگاه تهران  
۵- بررسی عملکرد بالاست با نصب در محوطه عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان به مدت چند ماه

۱- بررسی استانداردهای مربوط به لامپ و بالاست، کاتالوگ شرکت‌های سازنده لامپ و بالاست، مقالات IEEE در زمینه بالاست.  
۲- تهیه نمونه‌های خارجی و بررسی ساختار و عملکرد آنها  
۳- طراحی اولیه قسمت‌های مختلف بالاست شامل مدار قدرت، کنترل و تغذیه



## نمونه بالاست الکترونیکی ساخته شده

در این پروژه دو بالاست الکترونیکی نمونه برای لامپ ۲۵۰ وات سدیم پرفشار و ۲۵۰ وات جیوه پرفشار، طراحی و ساخته شد که ابتدا در آزمایشگاه روشنائی دانشکده فنی دانشگاه تهران توسط مجری تست شد و سپس در محوطه عمومی شرکت برق منطقه‌ای تهران مورد به مدت ۲ ماه به صورت آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

هم‌اکنون نیز شرکت برق منطقه‌ای تهران قصد دارد، نمونه ساخته شده بالاست را برای یک شرکت توزیع که برای دریافت نتایج پروژه اظهار تمایل کرده است، ارسال کند. البته در مورد نحوه واگذاری دانش فنی پروژه به شرکت توزیع، در جلسه هیئت مدیره بحث خواهد شد.

بسمه تعالي

خلاصه مدیریتی پروژه :

# طراحی و ساخت بالاست الکترونیکی برای لامپهای گازی ( بخار جیوه و بخار سدیم)

کارفرما: شرکت مسن انرژی قشم

مجری: شرکت ساخت صنعت گلستان

آذرماه ۱۳۹۶

لامپ‌های تخلیه در گاز، بار قابل توجهی از شبکه توزیع برق را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر برای روشن نمودن آنها از بالاست‌های مغناطیسی استفاده می‌شود. با پیشرفت المان‌های الکترونیکی قدرت، امکان ساخت بالاست‌های الکترونیکی فراهم شده و تحقیقات نشان می‌دهد استفاده از بالاست‌های الکترونیکی در مقایسه با بالاست‌های مغناطیسی، باعث افزایش طول عمر لامپ تا دو برابر، افزایش ضریب قدرت، حذف اثر سوسوزدن، ایجاد شار نوری ثابت در تغییرات وسیع ولتاژ ورودی، کنترل نور، امکان مدیریت مصرف انرژی روشنایی، کاهش ۵ تا ۱۰ درصد مصرف انرژی در شار نوری ثابت و ... خواهد شد. مزایای فوق و به خصوص کاهش مصرف انرژی، اهمیت تحقیق به منظور طراحی و ساخت این گروه از بالاست‌های الکترونیکی را نشان می‌دهد هدف از انجام این پروژه طراحی و ساخت بالاست الکترونیکی برای لامپ ۲۵۰ وات سدیم و ۲۵۰ وات جیوه می‌باشد.

### ۱- روند انجام پروژه

به منظور ساخت بالاست الکترونیکی ابتدا نحوه عملکرد انواع لامپ‌های گازی در راه‌اندازی و کار دائم مطالعه و در ادامه بالاست‌های مغناطیسی از نظر کنترل ولتاژ، جریان و توان لامپ مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ساخت بالاست الکترونیکی بهینه، چند نمونه موجود در بازار تهیه و نحوه عملکرد و مدار مربوطه بررسی گردید و در پایان با توجه به نتایج به دست آمده و مقالات معتبر IEEE مدار نهایی بالاست طراحی و ساخته شد. در ادامه بالاست الکترونیکی ساخته شده در آزمایشگاه روشنایی دانشگاه تهران مورد آزمایش قرار گرفت که نتایج رضایتبخش بوده است. در انتهای پروژه بالاست الکترونیکی به مدت چند ماه در محوطه عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان مورد تست عملکردی قرار خواهد گرفت.

بلاست الکترونیکی شامل سه قسمت مدار قدرت، مدار کنترل و مدار تغذیه بالاست است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

## ۱-۱- طراحی و ساخت مدار قدرت

بلوک دیاگرام مدار قدرت در شکل (۱) و شمای مدار قدرت در شکل (۲) آمده است. مدار قدرت دارای پنج بخش زیر می‌باشد :

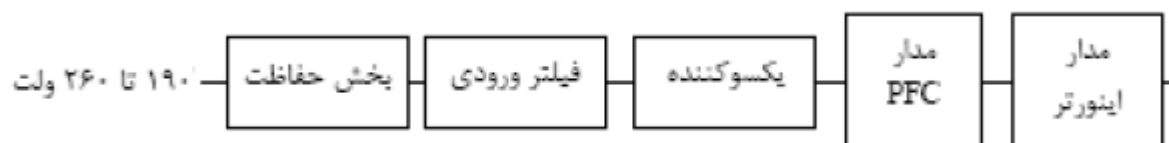
۱- بخش حفاظت که از بالاست الکترونیکی در مقابل اضافه ولتاژ و جریان اتصال کوتاه حفاظت می‌کند.

۲- فیلتر ورودی : مطابق شکل (۲)،  $C_{101}$  و  $L_{101}$  مدار فیلتر ورودی را تشکیل داده که از ورود فرکانس‌های بالای تولید شده توسط بالاست الکترونیکی به شبکه توزیع جلوگیری می‌کند.

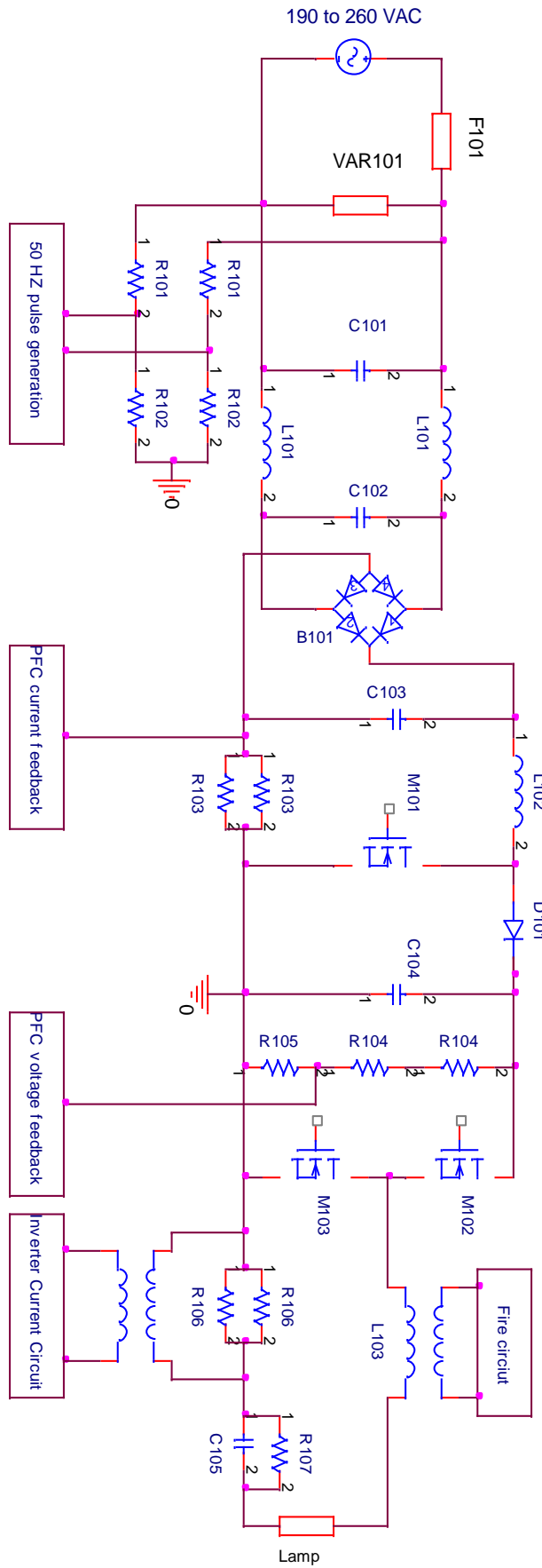
۳- یکسوکننده : ولتاژ ۲۲۰ ولت شبکه توسط پل  $B_{101}$  یکسو شده و در خازن کوچک  $C_{103}$  ذخیره می‌گردد. مدار تصحیح ضریب توان از ولتاژ خازن  $C_{103}$  استفاده می‌کند.

۴- مدار PFC (تصحیح ضریب توان) : سلف  $L_{102}$ ، ماسفت  $M_{101}$ ، دیود  $D_{101}$  و خازن  $C_{104}$  مدار تصحیح ضریب توان را تشکیل می‌دهند. مدار کنترل ضریب توان یا PFC یک رگولاتور سوئیچینگ از نوع boost است. ولتاژ دارای ریپل خازن  $C_{103}$  توسط این مدار به ولتاژ ثابت در دو سر خازن  $C_{104}$  برای استفاده در اینورتر تبدیل می‌گردد. این مدار علاوه بر واحد نمودن ضریب قدرت، تاثیر نوسانات ولتاژ شبکه را در عملکرد بالاست الکترونیکی از بین می‌برد. ولتاژ دو سر مقاومتهای  $R_{103}$  و  $R_{105}$  به منظور کنترل مدار PFC استفاده می‌شود.

۵- مدار اینورتر : اینورتر بالاست الکترونیکی به صورت نیم‌پل و عملکرد آن بر اساس رزونانس است. ماسفتهای  $M_{102}$  و  $M_{103}$  سوئیچ‌های مدار اینورتر، سلف  $L_{103}$  و خازن  $C_{105}$  المان‌های رزونانس می‌باشند. برای روشن نمودن لامپ ۲۵۰ وات سدیم در لحظه اول به ولتاژی در حدود ۴ کیلو ولت نیاز بوده که این ولتاژ توسط مدار آتش و سلف  $L_{103}$  ایجاد، و به لامپ اعمال می‌گردد. مدار کنترل با استفاده از مقاومتهای  $R_{106}$ ، جریان مدار اینورتر را کنترل می‌کند.



شکل (۱)، بلوک دیاگرام مدار قدرت

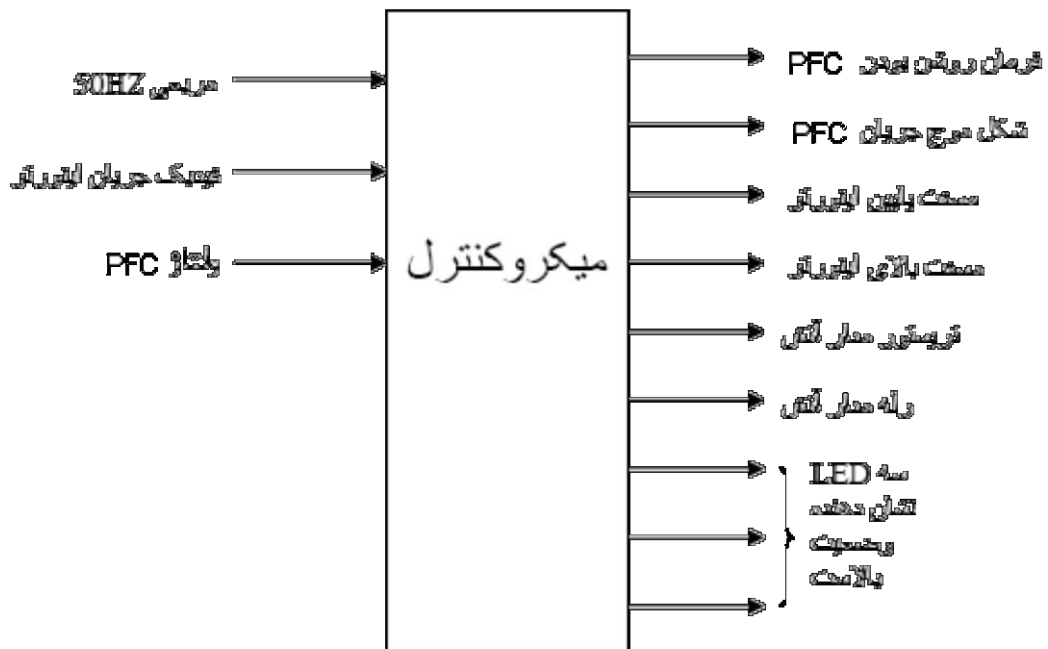


شکل (۲)، شمای مدار قدرت

### ۲-۱- طراحی و ساخت مدار کنترل

مدار کنترل بالاست الکترونیکی ۲۵۰ وات سدیم دارای دو قسمت دیجیتال و آنالوگ بوده که بخش دیجیتال بر اساس میکروکنترلر ATMEGA<sup>۸</sup> می‌باشد. وظایف مدار کنترل عبارتند از:

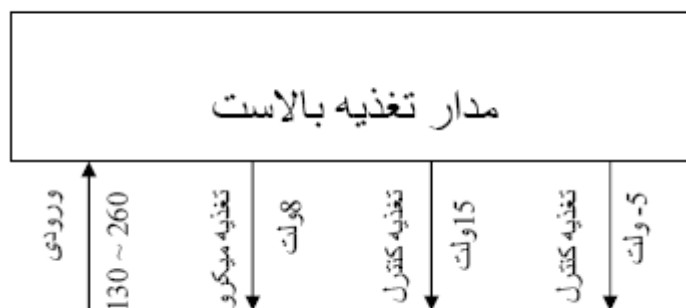
- ۱- ساخت موج مربعی سنکرون با شبکه به منظور کنترل مدار تصحیح توان و واحد نمودن ضریب قدرت
  - ۲- کنترل مدار تصحیح ضریب توان
  - ۳- کنترل اینورتر به منظور راه‌اندازی و استفاده از لامپ
  - ۴- کنترل مدار آتش به منظور ایجاد ولتاژ بالا برای شروع به کار لامپ ۲۵۰ وات سدیم
- ورودی و خروجی‌های میکروکنترلر ATMEGA در شکل (۳) آمده است.



شکل (۳)، ورودی و خروجی‌های میکروکنترلر

### ۳-۱- طراحی و ساخت مدار تغذیه

بخش دیجیتال مدار کنترل به ۵ ولت و بخش آنالوگ آن به ۵- و ۱۵ ولت نیاز دارد. مدار تغذیه بالاست الکترونیکی ولتاژ ۲۲۰ ولت شبکه را دریافت و ولتاژهای ۸، ۱۵ و ۵- را ایجاد می‌کند. ولتاژ ۵- و ۱۵ ولت مستقیماً در بخش آنالوگ مدار کنترل استفاده می‌گردد. با توجه به حساسیت تغذیه بخش دیجیتال مدار کنترل، از ولتاژ ۸ ولت به همراه یک رگولاتور برای ساخت ولتاژ ۵ ولت استفاده می‌گردد.



شکل (۴)، ورودی و خروجی‌های مدار تغذیه

## ۲- نتایج آزمون‌های عملکردی

در آزمایشگاه روش‌نایی دانشگاه تهران دو نوع بالاست الکترونیکی و مغناطیسی برای لامپ‌های ۲۵۰ وات سدیم و جیوه مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج به دست آمده مربوط به لامپ ۲۵۰ وات سدیم در جدول (۱) آورده شده و در ادامه نتایج به دست آمده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

### ۲-۱- مقایسه دو نوع بالاست از نظر تغییرات ولتاژ ورودی

یکی از معایب بالاست مغناطیسی تغییر توان ورودی به لامپ در اثر تغییرات ولتاژ ورودی است. کاهش توان ورودی به لامپ در اثر کاهش ولتاژ، به ترتیب درصد کاهش، باعث کاهش شار نوری لامپ، ایجاد طیف نوری نامناسب و در نهایت خاموش شدن لامپ خواهد شد. همچنین افزایش توان ورودی به لامپ در اثر افزایش ولتاژ ورودی، باعث کاهش طول عمر لامپ خواهد شد.

نتایج جدول (۱) نشان می‌دهد که تغییر ولتاژ ورودی از ۱۹۵ ولت تا ۲۴۸ ولت (در حدود ۸۵ تا ۱۱۰ درصد ولتاژ نامی) باعث تغییر توان ورودی به مجموعه لامپ و بالاست مغناطیسی از ۲۰۹ تا ۳۷۴ وات شده، در حالیکه مقدار نامی آن ۲۷۵ وات می‌باشد. جدول (۱) نشان می‌دهد که تغییرات ولتاژ ورودی از حدود ۸۵ تا ۱۱۰ درصد، تاثیر چندانی در توان ورودی به مجموعه لامپ و بالاست الکترونیکی ندارد.

## ۲-۲- مقایسه دو نوع بالاست از نظر ضریب قدرت

یکی از اهداف ساخت بالاست الکترونیکی رسیدن به ضریب قدرت ۰/۹ می‌باشد. نتایج به دست آمده در جدول (۱) نشان می‌دهد ضریب قدرت مجموعه‌ی لامپ ۲۵۰ وات سدیم به همراه بالاست مغناطیسی در ولتاژهای ۱۹۵، ۲۳۰ و ۲۴۸ ولت به ترتیب برابر ۰/۴۱، ۰/۴۶ و ۰/۴۸ بوده و بالاست الکترونیکی ضریب قدرت را در این سطوح ولتاژ به ۰/۹۹ افزایش داده است.

## ۲-۳- مقایسه دو نوع بالاست از نظر جریان ورودی

با افزایش ولتاژ ورودی به مجموعه لامپ و بالاست مغناطیسی، توان ورودی افزایش یافته و در نتیجه جریان ورودی نیز افزایش خواهد یافت. در حالیکه در نوع الکترونیکی به دلیل ثابت بودن توان، افزایش ولتاژ باعث کاهش جریان ورودی خواهد شد. همچنین به دلیل بالا بودن ضریب قدرت بالاست الکترونیکی نسبت به مغناطیسی، جریان بالاست الکترونیکی در توان مساوی کمتر از بالاست مغناطیسی است.

با توجه به جدول (۱)، افزایش ولتاژ از ۱۹۵ به ۲۴۸ ولت باعث افزایش جریان بالاست مغناطیسی از ۲/۶۲ به ۳/۱۱ شده در حالیکه جریان بالاست الکترونیکی از ۱/۳۴ به ۱/۱۳ کاهش یافته است. همچنین به دلیل تفاوت ضریب قدرت، جریان بالاست الکترونیکی همواره کمتر از بالاست مغناطیسی است.

## ۲-۴- مقایسه دو نوع بالاست از نظر ضریب هارمونیکی

با مقایسه نتایج جدول (۱) مشخص می‌گردد که ضریب هارمونیکی (THD) بالاست الکترونیکی ۲۵۰ وات سدیم کمتر از نوع مغناطیسی می‌باشد. به عنوان مثال ضریب هارمونیکی بالاست الکترونیکی برای ولتاژ نامی ۲۳۰ ولت، برابر ۶/۶۵ درصد، که این مقدار کمتر از ۹/۹۲ درصد بالاست مغناطیسی مشابه می‌باشد. بر اساس استاندارد (۲۰۰۲) ۸۲،۷۷ ANSIC حداکثر ضریب هارمونیکی برای روشنایی صنعتی برابر ۳۲ درصد تعیین شده که بالاست الکترونیکی ساخته شده شرایط استاندارد را برآورده می‌کند.

## ۲-۵- مقایسه دو نوع بالاست از نظر بهره نوری

یکی از مزایای بالاست الکترونیکی در مقایسه با بالاست مغناطیسی افزایش بهره نوری می‌باشد. مطابق جدول (۱)، بهره

نوري بالاست الكترونيكي به همراه لامپ ۲۵۰ وات سدیم همواره  
بیش از نوع مغناطیسی است.

الکترونیکی			مغناطیسی			نوع بالاست ۲۵۰ سدیم
۲۴۸	۲۳۰	۱۹۵	۲۴۸	۲۳۰	۱۹۵	ولتاژ (ولت)
۱/۱۳	۱/۲۱	۱/۳۴	۳/۱۱	۲/۶۹	۲/۶۲	جریان (آمپر)
۲۷۶/۹	۲۷۶/۳	۲۶۰/۲۰	۳۷۴/۲	۳۱۲/۵	۲۰۹/۱	توان ورودی (وات)
۰/۹۹	۰/۹۹	۰/۹۹	۰/۴۸	۰/۴۶	۰/۴۱	ضریب قدرت
۷/۴۱	۶/۶۵	۵/۶۶	۱۱/۳۰	۹/۹۲	۷/۸۰	درصد ضریب هارمونیکی
۳۱۳۰۹	۳۱۲۷۵	۲۹۲۵۵	۴۰۹۵۷	۳۴۶۱۸	۲۱۳۸۴	شار نوری (لومن)
۱۱۳/۰۷	۱۱۳/۱۹	۱۱۲/۴۳	۱۰۹/۴۵	۱۱۰/۷۸	۱۰۲/۲۷	بهره نوری (لومن بر وات)

جدول (۱)، نتایج حاصل از بالاست مغناطیسی و الکترونیکی در  
ولتاژهای ۱۹۵، ۲۳۰ و ۲۴۸ ولت

### ۳- ارزیابی اقتصادی

بالاست الکترونیکی ساخته شده در این پروژه به صورت  
آزمایشگاهی بوده و در صورت ادامه تحقیقات، امکان صنعتی  
نمودن طرح وجود دارد. یک بالاست الکترونیکی با کاربری صنعتی  
باید دارای مشخصات زیر باشد:

۱- دارای ضریب قدرت حداقل ۰/۹

۲- حداکثر ضریب هارمونیکی برابر ۳۲ درصد

۳- دارای بهره نوری بالاتر نسبت به مغناطیسی

۴- کنترل توان و جریان ورودی به لامپ در محدوده مجاز با وجود  
نوسانات ولتاژ ورودی

۵- دارای ضریب اطمینان بالا

۶- دارای حجم و وزن و قیمت مناسب

در ادامه منافع، هزینه‌ها و نسبت منافع به هزینه یک بالاست الکترونیکی با کاربرد صنعتی محاسبه شده است.

### ۱-۳- محاسبه منافع

استفاده از بالاست الکترونیکی در صنعت دارای مزایای زیادی بوده که به طور مبسوط در گزارش پروژه آمده است. در جدول (۲)، چهار مزیت مهم استفاده از بالاست الکترونیکی ۲۵۰ وات سدیم به همراه ارزیابی اقتصادی مربوطه، بر اساس قیمت‌های سال ۸۶ آورده شده است. منافع حاصل از استفاده بالاست الکترونیکی عبارتند از:

#### ۲-۳- صرفه‌جویی ناشی از افزایش ضریب قدرت

بر اساس محاسبات انجام شده در گزارش پروژه، استفاده از بالاست الکترونیکی برای لامپ ۲۵۰ وات سدیم باعث حذف یک خازن ۴۰ میکروفاراد با قیمت ۵۰۰/۰۰۰ ریال می‌گردد.

#### ۳-۳- صرفه‌جویی ناشی از افزایش طول عمر

فرض بر این است که بالاست الکترونیکی عمر مفید ۴۰/۰۰۰ ساعت در طول ده سال داشته باشد و با افزایش عمر مفید لامپ از ۲۰/۰۰۰ ساعت به ۴۰/۰۰۰ ساعت، باعث صرفه‌جویی در هزینه خرید و تعویض یک لامپ در مدت ده سال عمر مفید خود گردد. در این صورت باعث صرفه‌جویی برابر ۵۰۰/۰۰۰ ریال خواهد شد.

#### ۴-۳- صرفه‌جویی ناشی از کاهش هزینه تولید و انتقال

همچنین بالاست الکترونیکی با افزایش بهره نوری باعث کاهش ده درصدی در توان مصرفی گردیده که این مقدار بر اساس محاسبات انجام شده برابر ۲۷/۵ وات می‌باشد. اگر هزینه تولید و انتقال ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر کیلووات باشد، صرفه‌جویی در تولید و انتقال توان برابر ۱/۳۷۵/۰۰۰ ریال خواهد بود.

#### ۵-۳- صرفه‌جویی ناشی از کاهش هزینه انرژی مصرفی

کاهش توانی برابر ۲۷/۵ وات باعث صرفه‌جویی برابر ۱۱۰ کیلووات ساعت در سال گردیده و اگر هزینه هر کیلووات ساعت برابر ۷۰۰۰

ریال باشد، در هر سال هزینه‌ای برابر ۷۷۰٫۰۰۰ ریال و در ده سال هزینه‌ای برابر ۷٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال صرفه‌جویی خواهد شد. نتایج ارزیابی اقتصادی در جدول (۲) آمده است.

ردیف	شرح منافع	نحوه محاسبه	مبلغ به ریال
۱	افزایش ضریب قدرت	مطابق جدول (۱۰-۱) گزارش	۵۰۰٫۰۰۰
۲	افزایش طول عمر لامپ	مطابق جدول (۱۰-۲) گزارش	۵۰۰٫۰۰۰
۳	کاهش هزینه تولید و انتقال	مطابق جدول (۱۰-۳) گزارش	۱٫۳۷۵٫۰۰۰
۴	کاهش تلفات انرژی	مطابق جدول (۱۰-۴) گزارش	۷٫۷۰۰٫۰۰۰
	جمع		۱۰٫۰۷۵٫۰۰۰

جدول (۲)، منافع حاصل از جایگزینی بالاست الکترونیکی به جای بالاست مغناطیسی ۲۵۰ وات سدیم

### ۶-۳ - نسبت منافع به هزینه

بر اساس گزارش پروژه، قیمت تمام شده یک بالاست الکترونیکی ۲۵۰ وات سدیم در سال ۸۶ برابر ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ ریال و قیمت تمام شده یک بالاست مغناطیسی برابر ۵۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد. هزینه جایگزینی بالاست الکترونیکی به جای بالاست مغناطیسی برابر ۷۰۰٫۰۰۰ ریال خواهد بود. با توجه به جدول (۲)، منافع حاصل از این جایگزینی ۲٫۱۱۸٫۴۱۳ ریال می‌باشد و بنابراین نسبت منافع به هزینه این جایگزینی ۶/۰۶ خواهد بود. و این نسبت نشان دهنده اقتصادی بودن طرح می‌باشد.

عنوان	مبلغ (ریال)
قیمت تمام شده بالاست الکترونیکی ۲۵۰ سدیم	۱٫۹۵۰٫۰۰۰
قیمت تمام شده بالاست مغناطیسی ۲۵۰ سدیم	۵۰۰٫۰۰۰
هزینه (تفاوت قیمت دو بالاست)	۱٫۴۵۰٫۰۰۰
منافع بالاست الکترونیکی	۱۰٫۰۷۵٫۰۰۰
نسبت منافع به هزینه	۸٫۶۲

جدول (۳)، نسبت منافع به هزینه در جایگزینی بالاست  
الکترونیکی به جای مغناطیسی ۲۵۰ وات سدیم

#### ۴- نتایج و پیشنهادات

ارزیابی اقتصادی نشان می‌دهد که استفاده از بالاست الکترونیکی صنعتی شده دارای توجیه اقتصادی است. نتایج حاصل از این پروژه نشان می‌دهد که در صورت ادامه تحقیقات، امکان ساخت بالاست الکترونیکی با کاربری صنعتی وجود دارد. به منظور ادامه تحقیقات جهت صنعتی نمودن بالاست الکترونیکی برای لامپ‌های گازی، پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد:

۱- بر روی کاهش تلفات در بالاست الکترونیکی کار بیشتری انجام شده و با کاهش تلفات، لومن بر وات مجموعه بالاست و لامپ افزایش یابد. افزایش حتی یک درصد به بهره‌نوری لامپ و بالاست، باعث صرفه‌جویی بسیار بالا در انرژی و هزینه‌ها در حد کلان خواهد شد.

۲- با کاهش تلفات، حجم هیت‌سینگ و در نتیجه حجم بالاست و قیمت تمام شده بالاست کاهش می‌یابد.

۳- در مورد افزایش ضریب اطمینان بالاست الکترونیکی تحقیق شده و سعی گردد تا ضریب اطمینان عملکرد بالاست افزایش یابد.

۴- در مورد روش‌های کاهش صدمه به بالاست الکترونیکی در اثر ضربه، حرارت، رطوبت و ضربه‌های ولتاژ ورودی تحقیق گردد.

۵- در مورد نواحی ناپایداری لامپ‌های سدیم و متال‌های تحقیق و در مورد روش‌های کاهش ناپایداری‌ها مطالعه گردد.

۶- در مورد روش‌های ساده‌سازی مونتاژ بالاست الکترونیکی مطالعه و این روش‌ها در طراحی منظور گردد.